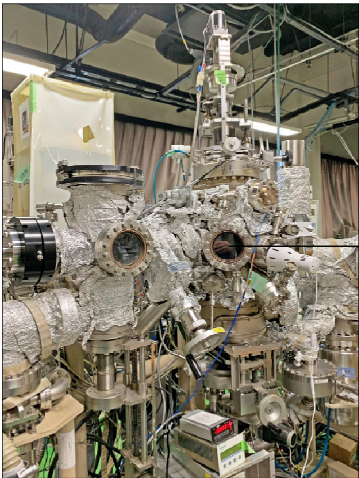
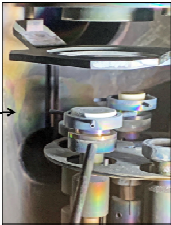
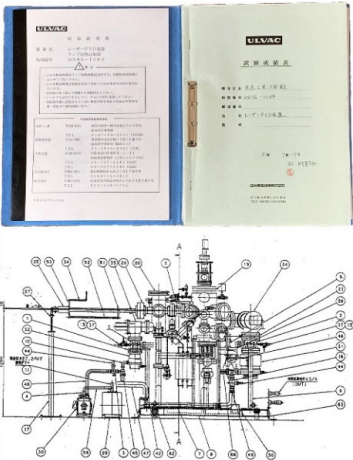


酸化物TFTの実用化に貢献した卓越した材料探索ツール

登録番号	第 00378 号		
登録年月日	2024（令和6）年9月10日	登録区分	第二種 （単一又は極めて少量生産されたもの）
名 称 （型式等）	パルスレーザーデポジション(PLD) 酸化物薄膜作製装置		
所 在 地	神奈川県横浜市 東京科学大学		
所 有 者 （管理者）	東京科学大学		
製 作 者 （社）	日本真空技術株式会社（現 株式会社アルバック）		
製 作 年	1997年		
初 出 年	1997年		
選定理由	本資料は、材料と半導体の2分野で傑出した成果に貢献したパルスレーザーデポジション(PLD)装置である。この装置で作製したInGaO ₃ (ZnO) _m [IGZO]の薄膜トランジスタ(TFT)は、エピタキシャル結晶膜では多結晶シリコンに匹敵する移動度を、アモルファス膜ではアモルファスシリコンよりも1桁高い値を実現した。これらの研究成果はScience(2003)とNature(2004)に報告され、IGZOの半導体としての可能性を初めて明らかにした。装置には当時の制御機能が堅持されており、納入時の書類・図面も残されていることなどから、学界及び産業界にとって非常に重要である。		
登録基準	一ーハ （新たな科学技術分野の創造に寄与したもの）		

公開・非公開	非公開
写 真	 PLD酸化物薄膜作製装置 [メインチャンバー]  メインチャンパーの内部  納入時の書類・図面一式 [試験成績表、取り扱い説明書、装置図面等]
その他参考となるべき事項	